نشریه علمی «راوار» سال هشتم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹؛ ص ۹۶– ۸۹

علمي- پژوهشي

کاهش سطح گلبرگهای فرعی در آنتنهای سهموی بازتابنده

سید میلاد حسینی'، سید محمد هاشمی **، پیمان حسنی ۳

۱- کارشناسی ارشد ۲- استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷، پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۳)

چکیدہ

در سالهای اخیر تحقیقاتی در زمینه کاهش سطح گلبرگ فرعی (SLL) آنتنهای بازتابنده سهموی برای اهداف نظامی و غیرنظ امی صورت گرفته است. در این تحقیقات از روشهای مختلف از جمله لبه دادن به آنتن بازتابنده، تغییر امپدانس صفحه در لبهها، قرار دادن قـرص فلـزی در سطح بازتابنده و یا عناصر تشدیدی و غیر تشدید در لبهها استفاده شده است. در این مقالـه تـأثیر فاصـله کـانونی و قطـر آنـتن بازتابنـده سهموی بر کاهش سطح گلبرگ فرعی بررسی شده و بدون استفاده از ساختارهای پیچیده و پر هزینه، با استفاده از بهینه سازی ساختار اصلی آنتن کاهش گلبرگ فرعی محقق شده است. بسته به نیاز به بهره بیشینه، کوچکترین اندازه و یا کم ترین سطح گلبرگ فرعی طراحی می تواند صورت گیرد. با توجه بـه هـدف کـم تـرین سـطح گلبـرگ فرعـی، آنـتن پیشـنهادی در ایـن مقالـه دارای فرکـانس کـاری H7/0 املی مورت گیرد. با توجه بـه هـدف کـم تـرین سـطح گلبـرگ فرعـی، آنـتن پیشـنهادی در ایـن مقالـه دارای فرکـانس کـاری H7/0 می تواند مورت گیرد. با توجه بـه هـدف کـم تـرین سـطح گلبـرگ فرعـی، آنـتن پیشـنهادی در ایـن مقالـه دارای فرکـانس کـاری H7/0 می می و ط مورت گیرد. با توجه بـه هـدف کـم تـرین سـطح گلبـرگ فرعـی، آنـتن پیشـنهادی در ایـن مقالـه دارای فرکـانس کـاری H7/0 GHz می تواند مورت گیرد. با توجه بـه هـدف کـم تـرین سـطح گلبـرگ فرعـی، آنـتن پیشـنهادی در ایـن مقالـه دارای فرکـانس کـاری H7/0 GHz می تواند مورت ایر در ایر ایرای در مقدات عاو H است. این آنتن در فرکانسهای J۹۵ و H7 (GHz)، بهترتیب سطح گلبـرگ فرعـی ۲۰/۷۴ - و ۲۵/۹۴ - را، داراست.

کلید واژهها: آنتن بازتابنده سهموی، سطح گلبرگ فرعی، بهینهسازی متغیرهای بازتابنده، فاصله کانونی و قطر بازتابنده

۱– مقدمه

امروزه استفاده از آنتنهای بازتابنده بسیار افزایش یافته است. کاربرد آنها در مواقعی که فاصله بین فرستنده و گیرنده زیاد است بسیار قابل توجه است. تمامی آنتنهای بازتابنده در مشخصه تشعشعی خود دارای یک گلبرگ اصلی و تعداد بسیار زیاد گلبرگهای فرعی هستند. البته بسته به کاربرد آنتن، میزان و چگونگی هر یک از این گلبرگها میتواند مهم باشد. از عوامل تاثیرگذار بر گلبرگهای فرعی و گلبرگ اصلی میتوان به مواردی از قبیل [۱]: جنس آنتن، ترکهای روی آنتن، ابعاد، انحنای آنتن، استفاده از دیسکهای برآمده روی سطح بازتابنده، فاصله تغذیه تا آنتن و نوع آنتن (آفست یا معمولی [۲]) اشاره کرد.

یکیاز راههای بهبود عملکرد بازتابندهها کاهش سطح گلبرگ فرعی است [۳]. کاهش سطح گلبرگ فرعی کاربردهای نظامی و غیر نظامی دارد که در زمینه نظامی کاربردهایی از قبیل مبارزه با اختلال در فضای اطراف کشتی در حال انجام عملیات اختلال فریب و کاهش اختلال در رادارهای شناسایی هواپیماهای رادار گریز را داراست. از نظر غیر نظامی در کاهش اختلال مخابراتی در

پخش تلویزیونی و کاهش تـزویج آنـتنهـای بازتابنـدهای کـه در مجاورت یکدیگر قرار دارند، کاربرد دارد.

آنتنهای بازتابنده در چهار دسته کروی، کنج، مسطح [۴] و سهموی مورد مطالعه قرار می گیرند. آنتنهای سهموی در دو حالت تغذیه از جلو و کسگرین [۵-۶] تغذیه می شوند. تغذیه از جلو می تواند به صورت پر تو انباشته، آفست، تک قطبی، شکل داده شده و یا استاندارد باشد [۱]. با توجه به این که در این مقاله آنتن بازتابنده سهموی تغذیه از جلو استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته، در ادامه تحقیقات صورت گرفته از این آنتن بررسی شده است.

در کاهش سطح گلبرگ فرعی ملاحظاتی از قبیل تغییرات ناچیز بهره و اندازه آنتن وجود دارد که باید در حد امکان در بیشترین بهره و کوچکترین اندازه آنتن کمترین سطح گلبرگ فرعی را داشته باشیم. از طرفی با پیچیدگی کمتر در ساختار، هزینه ساخت آنتن به حداقل برسد.

یکیاز روشهای کاهش سطح گلبرگ فرعی ایجاد انحنا در لبههای بازتابنده است. این امر موجب عدم قطع ناگهانی جریانهای لبهای و در نتیجه کاهش تشعشع ناخواسته خواهد شد [۷– ۹]. در مقاله [۷] با انحنا در لبههای بازتابنده، سطح گلبرگ فرعی طB ۲۰- گزارش شده است.

^{*}رايانامه نويسنده مسئول: sm.hashemi@sru.ac.ir

یکی دیگر از روشها، افزایش امپدانس اطراف و لبههای آنتن و بالا بردن مقاومت سطحی برای جلوگیری از جریانهای لبهای است، این کار را میتوان با افزودن ماده تلفاتی در لبهها یا اطراف آنتن بازتابنده انجام داد، که البته ممکن است کارایی آنتن کاهش پیدا کند [۸ و ۱۰- ۱۲].

روش دیگر، پیادهسازی عناصر تشدید و غیر تشدید در اطراف یا لبههای بازتابندهها جهت کاهش گلبرگهای فرعی است [۲]. با عناصر تشدید و غیر تشدید بهترتیب سطح گلبرگ فرعی dB ۳۶-و dB ۳۸- با بهره ۳۳ و ۳۲/۸ dBi گزارش شده است. با قراردادن قرصهای فلزی کوچک در اندازه، ارتفاع و مکانهای مشخص میتوان سطح گلبرگ فرعی را در یک منطقه خاص کاهش داد [۱۳].

در تحقیقات اخیر روشهای مختلف برای کاهش سطح گلبرگ فرعی استفاده شدهاند که عبارتاند از: انحنا در لبههای بازتابنده [۷]، استفاده از حلقههای جاذب [۱۴]، افزودن روزنههای نامتناوب [۱۵]، طراحی شبکه توری شکل مقابل بازتابنده [۱۶]، تغییر نسبت عمق به قطر بازتابنده [۱۷]، تغییر لبه بازتابنده با عناصر تشدید [۳] و غیر تشدید [۱۸]. در این مقاله کاهش سطح گلبرگ فرعی با تنظیم قطر و فاصله کانونی صورت گرفته است.

در این مقاله، ساختاری ساده با حداقل سطح گلبرگ فرعی و بهره ثابت از طریق تنظیم عناصر فاصله کانونی و قطر آنتن ارائه شده است. چارچوب مقاله در ادامه به این شرح است. در بخش دوم، روشهای مختلف کاهش سطح گلبرگ فرعی معرفی شده، روند نمای طراحی آنتن بازتابنده سهموی پیشنهادی ارائه شده و روشهای شبیهسازی بررسی می شوند. در بخش سوم، عناصر آنتن بازتابنده سهموی پیشنهادی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و تأثیر هر یک بر سطح گلبرگ فرعی بررسی شده است. در این بخش نمونه پیشنهادی با کارهای گذشته مقایسه شده است. در بخش جهارم، به جمعبندی مقاله پرداخته می شود.

۲- رونــد نمـای طـرح پیشــنهادی و روشهـای شبیهسازی

در شکل (۱) روند نمای بهینه سازی آنتن پیشنهادی در این مقاله ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از روابط طراحی،

ابعاد اولیه آنتن بازتابنده سهمی گون به دست آمده است. یکی از اصلی ترین متغیرهای این آنتن ها میزان بهره بالای آن هاست، در این مرحله بهره آنتن را محاسبه کرده، اگر بهره دارای مقدار مورد نظر بود، مرحله بعد آغاز خواهد شد.

هدف طراحی کاهش سطح گلبرگ فرعی آنتن بازتابنده بوده که با تغییر عمق آنتن میتوان به آن دست یافت، در این مرحله با انجام تغییرات مورد نظر سطح گلبرگ فرعی را مورد بررسی قرار داده و مجددا بهره آنتن محاسبه می شود. اگر بهره و سطح گلبرگهای فرعی مطابق با اهداف مورد نظر بود، شبیه سازی پایان می یابد.

عنصرهای اصلی بازتابنده سهموی، قطر R×2 = D و عمق آن است که با فاصله کانونی در رابطه (۱) مرتبط هستند:

$$f = \frac{D^2}{16F} \tag{1}$$

که تعریف متغیرهای فرمول در شکل (۳) آمده است. قدم اول در طراحی آنتن بازتابنده سهمی گون با استفاده از بهینهسازی، دانش بر روش های شبیه سازی آن است. در ادامه تمام شبیه سازی ها در نرمافزار تمام موج FEKO صورت گرفته است. برای شبیه سازی عناصر با ابعاد فیزیکی مورت گرفته است. برای شبیه سازی عناصر با ابعاد فیزیکی Multilevel Fast Multipole Method ابت، (MLFMM) به جای روش ممان (MOM) که زمانبر است، استفاده می شود.

توضیحات روش MLFMM در نرمافزار موجود بوده و قابل استفاده میاشد [۱۹]. برای عناصری که زیر مجموعهای از طراحی هستند و ابعادی بزرگ دارند، برای مثال آنتن شیپوری در آنتن سهمی گون، از روش Large Element Physical Optics) استفاده می شود. روش هایی برای تغذیه آنتن بازتابنده جایگزین آنتن شیپوری میتواند باشد که باعث افزایش سرعت شبیه سازی می شوند. این منابع تغذیه معادل عبارتاند از تغذیه میدان نزدیک و کروی میدان دور که در این بین شبیه سازی با منبع تغذیه معادل کروی میدان دور از شرعت بیشتری برخوردار است.



شکل (۱): روند نمای بهینهسازی آنتن بازتابنده سهمیگون با هدف کاهش سطح گلبرگهای فرعی.

جدول (۱): روشهای مختلف در شبیهسازی آنتن بازتابنده از نظر سرعت شبیهسازی و حافظه دستگاه.

		-
مدت زمان	حافظه	
شبيەسازى	مورد نياز	روش شبيەسازى
(S)	(MB)	
	491.	MLFMM
14.4		(برای کل ساختار)
***	٧٠٠	MLFMM برای آنتن شیپوری و
1771		PO برای آنتن بازتابنده
61	۲۸۵	MLFMM برای آنتن شیپوری و
,,,,,		LE-PO برای آنتن بازتابنده
1.6	198	MOM برای آنتن شیپوری و
		LE-PO برای آنتن بازتابنده
	۴۱	تغذيه معادل ميدان نزديك براي
١٨٣		آنتن شیپوری و LE-PO برای
		آنتن بازتابنده
	٣٢	تغذيه معادل كروي ميدان دور
47		برای آنتن شیپوری و LE-PO
		برای آنتن بازتابنده

جدول (۱) روشهای یاد شده را از نظر سرعت و حافظه مورد نیاز برای یک نمونه دستگاه پردازنده بررسی می کند. برای بررسی میزان دقت در شبیهسازی با روشهای مذکور، بهره بازتابنده سهمی گون در فر گانس ۱۲/۵ GHz با تغذیه آنتن شیپوری استوانهای مورد مطالعه قرار گرفته است. بازتابنده قطر ۸۳۶ دارد. شیهسازیها در نرمافزار تمام موج FEKO صورت گرفته است. نتایج چندین شبیهسازی در مقایسه بهره حاصل از روشهای مختلف شبیهسازی آنتن بازتابنده سهمی گون با تغذیه معادل کروی میدان دور، میدان نزدیک و آنتن شیپوری در شکل (۲) نشان داده شده است. در شبیهسازی تمامی این روشها از نرمافزار FEKO استفاده شده است. در ادامه و با توجه به شکل، موارد قابل نتیجه گیری مورد بررسی و شرح قرار می گیرد:

- ۱) تفاوتی که بین شبیهسازی با تغذیه معادل میدان نزدیک و یا میدان دور کروی با تغذیه آنتن شیپوری دیده میشود بهدلیل تزویج بین آنتن شیپوری و بازتابنده سهمیگون است. این تزویج در روش MLFMM در نظر گرفته میشود [۱۹].
- ۲) در روش LE-PO هیچ محدودیتی روی مثلثهای مشبندی وجود ندارد که البته باید به شکلی دقیق این کار صورت گیرد به طوری که برای صفحات مسطح تنها به دو مثلث برای شبیه سازی نیاز است [۱۹].



شکل (۲): مقایسه بهره حاصل از روشهای مختلف شبیهسازی آنتن بازتابنده سهمی گون با تغذیه معادل کروی میدان دور، میدان نزدیک و آنتن شیپوری [۱۹].

در ادامه طراحی از روش تغذیه معادل کروی میدان دور و LE-PO استفاده شده که در مقایسه با دیگر روشها سرعت بالاتری داشته، نیاز به حافظه بالای دستگاه نداشته و در مقایسه با روشهای دیگر سطح گلبرگ فرعی بالاتری را نشان میدهد که در نتیجه میتوان نتیجه گرفت در صورت شبیهسازی با دیگر روشها نتیجه مطلوبتری حاصل میشود.

۳- مطالعه عناصر آنتن بازتابنده سهموی پیشنهادی

ساختار آنتن شبیه سازی شده در شکل (۳) نشان داده شده است. طراحی در فرکانس ۱۲/۵ GHz صورت گرفته است [۱]. در ادامه چگونگی دستیابی به ابعادی بهینه برای بازتابنده سهمی گون پیشنهادی با استفاده از تنظیم عنصرهای شعاع آنتن بازتابنده (R) و فاصله کانونی (f) نشان داده شده است.



شکل (۳): ساختار آنتن بازتابنده سهموی.

جدول (۲): تغییرات سطح گلبرگ فرعی آنتن بازتابنده با تغییر شعاع و فاصله کانونی.

•/۴٧٧٣۶	•/477•4	•/47•88	•/۴۳۲	•/٣٨٨	R f
- 36/20	-۳۵/9۲	-۳۵/۷۹	-۳۱/۸۵	- 4 9/2V	•/9
-47/42	-44/20	-47/87	-۳۷/۸۴	-٣۶/٢٣	•/474
-41/18	-44/38	-44/91	-۳۷/۴・	-۳۵/۹۶	•/490
- * • / V *	-47/17	-42/11	-۳٩/١٩	-۳۷/۱۶	•/409
-٣۶/٩۶	-76/68	-٣۶/٧٨	- 36/71	<u> </u>	•/٣٣

•/۴٧٧٣۶	•/FVT•F	•/47•**	•/FTT	•/٣٨٨	R f
4.140	4./61	۴۰/۳۸	٣٩/٨٨	34/14	•/۶
89/22	۳٩/٢١	۳٩/۲۰	۳۸/۴۷	۳۸/۵۷	•/474
۳٩/۰ λ	٣٩/٠٧	٣٩/٠٧	۳۸/۸۶	۳۸/۴۳	•/490
۳۸/۹۳	۳۸/۹۲	۳۸/۹۲	۳٩/٧٢	۳۸/۳۷	•/409
36/20	36/20	36/20	۳۶/۲۹	86/28	•/٣٣

جدول (٣): تغییرات بهره آنتن بازتابنده با تغییر شعاع و فاصله کانونی.

آنتن مرجع شعاع ۱۹۳۲ و فاصله کانونی ۱۶، متر داشته که بهره dB ۹۹/۸۸ و سطح گلبرگ فرعی dB ۹۱/۸۵ دارد. جدول ۲، تغییرات گلبرگ فرعی آنتن بازتابنده سهمی گون بر حسب dB با تغییر R و f بر حسب متر نشان میدهد. با توجه به جدول با کاهش فاصله کانونی و افزایش شعاع آنتن بازتابنده سطح گلبرگ فرعی به شکلی غیر همگن روند کاهشی داشته ولی همان طور که از جدول مشخص است از مقادیری به بعد برای فاصله کانونی و شعاع آنتن سطح گلبرگ فرعی افزایش پیدا کرده است. کمترین سطح گلبرگ فرعی افزایش پیدا کرده است. کمترین شیه سازی حاصل شده است.

همانطور که قبلا اشاره شد مصالحهای بین اندازه آنتن، سطح گلبرگ فرعی و بهره آنتن بازتابنده وجود دارد که در ادامه برای بررسی این مهم تغییرات بهره آنتن بازتابنده بر حسب dBi با تغییر مقادیر مختلف R و f بر حسب متر در جدول (۳) نشان داده شده است. با توجه به جدول، با افزایش فاصله کانونی و شعاع آنتن بازتابنده، بهره روند افزایشی داشته است. از جدول مشخص است که بالاترین بهره در شعاع m ۲۶۷۳۶۶ و فاصله کانونی m /۶ اتفاق میافتد که ابعاد آنتن بازرگ است و سطح گلبرگ فرعی حدود db ۸ بیشتر است که مطلوب نیست.

آنــتن بازتابنــده پیشــنهادی بـا شـعاع m ۸۸/۴۷۰۸ و فاصله کـانونی m ۰/۴۶۵ بهـره db ۳۹/۰۷ دارد کـه بـا توجـه بـه انـدازه مناسب و سـطح گلبـرگ فرعـی پـایین مطلـوب در طراحـی است. بـا اسـتناد بـر نتـایج حاصـله، سـطح گلبـرگ فرعی آنتن پیشـنهادی بـه مقـدار چشـمگیـر db ۲۱ نسبت بـه آنتن مرجع کاهش یافتـه و ایـن در حـالی است کـه بهـره تنهـا ۸/۱ کاهش یافته است.



شکل (۴). تغییرات سطح گلبرگ فرعی و بهره آنتن بازتابنده با تغییر فاصله کانونی در صفحه الف) x-z (ب y-z

شکلهای (۴- الف و ب) نتیجه شبیه سازیهای مختلف را در تغییرات سطح گلبرگ فرعی و بهره آنتن بازتابنده با تغییر f بهترتیب در صفحات x-z و x-z نشان می دهند. همان طور که در شکلها مشخص است، سطح گلبرگ فرعی با کاهش f روندی کاهشی داشته که البته بعد از مقدار بهینه ۰/۴۶۵ m به افزایشی تبدیل وضعیت پیدا کرده است.

شکلهای (۵- الف و ب) نتیجه شبیه سازیهای مختلف را در تغییرات سطح گلبرگ فرعی و به ره آنتن باز تابنده با تغییر R به ترتیب در صفحات x-z و x-z نشان می دهند. همان طور که در شکلها مشخص است، سطح گلبرگ فرعی با افزایش R روندی کاهشی داشته که البته بعد از مقدار بهینه ۲۰/۴۷۰۸۸ m افزایشی تبدیل وضعیت پیدا کرده است.

مقادیر عناصر اصلی در طراحی آنتن بازتابنده سهموی پیشنهادی که حاصل از نتایج شبیهسازیهای بالا و مطالعه پارامتری است در جدول (۴) نشان داده شده است.

شکلهای (۶- الف و ب) نتیجه شبیهسازیهای مختلف را در تغییرات سطح گلبـرگ فرعـی و بهـره آنـتن بازتابنـده بـا تغییـر فرکـانس بـهترتیـب در صـفحات x-z و y-z نشـان مـیدهنـد. همانطور که در شکل مشخص است، سـطح گلبـرگ فرعـی بـا افزایش فرکانس روندی کاهشی داشته است.



Phi (deg)

0

100

200

شکل (۵): تغییرات سطح گلبرگ فرعی و بهره آنتن بازتابنده با تغییر شعاع در صفحه الف) x-z . ب

-100

-200





شکل (۶): تغییرات سطح گلبرگ فرعی و بهره آنتن بازتابنده با تغییر فرکانس در صفحه الف) x-z ب) y-z .

جدول (۴): مقادیر عناصر اصلی در طراحی آنتن بازتابنده سهمی گون

پیشنهادی (**آنتن اصلی مرجع**).

فاصله کانونی (f)	ش ع اع (R)	ابعاد واحد
46/0 (8+/+)	47/• 88 (47/7)	سانتيمتر
۱۹/۳۷۵ (۲۵)	19/88 (18)	λ

سطح گلبرگ فرعی در فرکانسهای ۶/۵، ۱۲/۵ و ۱۸/۵ گیگاهرتز بهترتیب برابر با طB، ۲۰۰/۷۶ طB، ۴۴/۹۱ و ۲۶/۱۵ در صفحه x-z شده است. سطح گلبرگ فرعی در فرکانسهای ۶/۵، ۲/۱۵ و ۱۸/۵ گیگاهرتز بهترتیب برابر با طB مرکانسهای ۶/۵، ۲/۱۵ و ۱۸/۵ گیگاهرتز بهترتیب برابر و ۱۸/۵ میکاهرتز بهترتیب برابر با طB ۲۳/۳۵ – ۴۶/۵ و ۱۸/۵ گیگاهرتز بهترتیب برابر با طB ۲۳/۳۵ – ۴۶/۵ طB، ۴۵/۴۶ و

شکلهای (۷- الف و ب) مقایسهای مابین آنت بازتابنده مرجع و پیشنهادی در ارتباط با تغییرات سطح گلبرگ فرعی بر حسب فرکانس در بازه GH2 ۶/۵ تا ۱۸/۵ GHz بهترتیب در صفحات z-z و z-z نشان میدهند. همان طور که در شکل مشخص است، سطح گلبرگ فرعی با افزایش فرکانس روندی کاهشی داشته و در فرکانسهای بالاتر اختلاف سطح گلبرگ فرعی از مرجع بیشتر میشود. اختلاف سطح گلبرگ فرعی از فرعی از مرجع بیشتر میشود. اختلاف سطح گلبرگ فرعی از مراح د فرکسانس GH2 با ۲۵ مر منحه z-۷ اختلاف سطح گلبرگ فرعی از dB ۲ در فرکانس GH2 به ۱۸/۵ GHz به ۱۸/۵ GHz در فرکانس ۱۸/۵ GH2 رسیده است.

شکل (۸) مقایسهای مابین آنتن بازتابنده مرجع و پیشنهادی در ارتباط با تغییرات بهره بر حسب فرکانس در بازه ۶/۵ تـا ۱۸/۵ گیگاهرتز نشان میدهد. همانطور که در شـکل مشخص است، بهره با افزایش فرکانس روندی افزایشی داشته و اخـتلاف بهره مرجع و آنتن پیشنهادی در طول فرکانس ثابت مانده است که در حدود طB ۸/۰ است.

سطح گلبرگهای فرعی ساختارهای طراحی شده در مقالات و طرح پیشنهادی در جدول (۵) مقایسه شده است. با توجـه بـه جدول، در طراحی پیشنهادی سطح گلبرگهای فرعی نسبت بـه پژوهشهای قبل بهبود چشمگیری داشته است. تغییـرات سطح گلبـرگ فرعـی و بهـره آنـتن بازتابنـده سـهموی پیشـنهادی در شکلهای ۹-الف و ب بهترتیب در صفحات z-z و z-y در فرکانس ۱۲/۵ گیگاهرتز نشان داده شـده است. آنـتن پیشـنهادی سطح گلبرگ فرعی ۴۲/۹۱ و ۴۳/۵ – بهترتیب در صفحات z-z و z-y

الگوی تشعشعی صفحه E و H ایـن آنــتن بــهترتیـب در شکلهای (۱۰– الف) و ب نشان داده شده است.





سهموی پیشنهادی.

جدول (۵): مقایسه نتایج آنتن بازتابنده پیشنهادی و ساختارهای

پيسين.				
سطح گلبرگ فرعی	روش کاهش سطح گلبرگ فرعی	منبع		
-7∙ dB	انحنا در لبهها	[¥]		
-YO dB	استفاده از حلقههای جاذب	[14]		
-۲۵ dB	افزودن روزنههاي نامتناوب	[16]		
-7Y dB	طراحی شبکه توری شکل مقابل بازتابنده	[18]		
−۳۵ dB	تغییر نسبت عمق به قطر	[1¥]		
−٣۶ dB	تغییر لبه بازتابنده (عناصر تشدید)	[٢]		
-۳λ dB	تغییر لبه بازتابنده (عناصر غیر تشدید)	[14]		
-۴۵ dB	تغییر فاصله کانونی و شعاع باتابنده	ساختار پیشنهادی		

۴- نتیجهگیری

در این مقاله تأثیر فاصله کانونی و قطر آنتن بر کاهش سطح گلبرگ فرعی بررسی شده و بدون استفاده از ساختارهای پیچیده و پر هزینه و نیز ابعادی کوچک نتیجهای مطلوب حاصل شده است. بسته به نیاز به بهره بیشینه، کوچکترین اندازه و یا کمترین سطح گلبرگ فرعی طراحی میتواند صورت گیرد. با توجه به مدف کمترین سطح گلبرگ فرعی، آنتن پیشنهادی با فرکانس مدف کمترین سطح گلبرگ فرعی، آنتن پیشنهادی با فرکانس کاری GHz (۲۹/۲۴، فطر آنتن در فرکانسهای GHz - بهترتیب در صفحات E و H دارد. این آنتن در فرکانسهای GHz (۲۹ مار ۵ مار) دارد.

- [11], R. L. Haupt, "Low sidelobe resistive reflector antenna." U.S. Patent No. 5,134,423. 28 Jul. 1992.
- [12] S. V. Nechitaylo, A. Z. Sazonov, and O. I. Sukharevsky. "Calculation of electromagnetic field in near field zone of reflector antenna with edge radar absorbing coating." Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2002. MMET'02. 2002 International Conference on. Vol. 2. IEEE, 2002.
- [13] D. Jacavanco, "Reflector antenna having sidelobe suppression elements." U.S. Patent No. 4,631,547. 23 Dec. 1986.
- [14] H. Chou, "Radiation Sidelobe Reduction and Focus Properties of Reflector Antennas by Grating the Aperture Field via Nonperiodic Fresnel-Zone Plate Lens," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 5, pp. 2634-2639, May 2018.
- [15] S. Tuan, C. Sun, H. Ho and H. Chou, "On the sidelobe reduction of reflector antenna's radiation by using non-periodic grating apertures," 2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC), Shenzhen, pp. 132-134, 2016.
- [16] J. R. de Lasson, C. Cappellin, R. Jorgensen, L. Datashvili and J. Angevain, "Advanced techniques for grating lobe reduction for large deployable mesh reflector antennas," 2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, San Diego, CA, pp. 993-994, 2017.
- [17] Bo Sun, Jinghui Qiu, Caitian Yang and Lingling Zhong, "Effect of design parameters on sidelobe level of short-focus parabolic reflector antenna," 2008 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility and 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, Singapore, pp. 851-854, 2008.
- [18] A. A. Kishk and L. Shafai, "Small reflector antenna with low sidelobes," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 51, no. 10, pp. 2907-2912, Oct. 2003.
- [19] Electromagnetic Simulation Software, Altair Feko.

۵- مراجع

- C. A. Balanis, "Antenna Theory analysis and design", John Wiley & Sons, fourth edition, 2016.
- [2] P. A. Venkatachalam, N. Gunasekaran and K. Raghavan, "An offset reflector antenna with low sidelobes", IEEE Transactions on Antennas and Propagation AP-33, No.6, June.1985.
- [3] H. Chou and H. Ho, "Local Area Radiation Sidelobe Suppression of Reflector Antennas by Embedding Periodic Metallic Elements Along the Edge Boundary," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 10, pp. 5611-5616, Oct. 2017.
- [4] S. H. Sedighi, M. Salimi, "Smart Antenna Design with Arbitrary Tilit for Wireless Communication." Applied Electromagnetics, 2 (3), 51-57, 1394. (In Persion)
- [5] M. Fertokzadeh, S. H. Mohseni Armaki, "Millimeter Wave Near-field Focusing Cassegrain Reflector Antennas." Applied Electromagnetics, 2 (3), 41-49. 1394 (In Persion)
- [6] S. Ebrahimi, S. H. Mohseni Armaki, A. Erfanian, "Design and Implementation of Cassegrain Antenna with 37dB Gain in Millimeter Wave Spectrum." Applied Electromagnetics, 2 (3), 11-20, 1394. (In Persion)
- [7] R. A. Shore and A. D. Yaghjian, "Application of incremental length diffraction coefficients to calculate the pattern effects of the rim and surface cracks of a reflector antenna," in IEEE Transaction on Antennas and Propagation, vol. 41, no. 1, pp. 1-11, Jan 1993.
- [8] G. L. James, and V. Kerdemelidis. "Reflector antenna radiation pattern analysis by equivalent edge currents." IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2 19-24, 1973.
- [9] W. D. Burnside, et al. "Curved edge modification of compact range reflector.", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 35.2, 176-182, 1987.
- [10] Chou, HsiTseng, ShihChung Tuan, and YuTing Hsiao. "Hybrid GB and PO analysis of electromagnetic radiation/scattering from large reflector antennas with tapered impedance surfaces." Microwave and optical technology letters 42.1, 34-37, 2004.